

Автоматизированный анализ наноструктур полупроводниковой электроники

Представляем группу решений **SIAMS-CP Semi**[™], входящую в состав аналитического комплекса **SIAMS-CP Nanotech** и предназначенную для автоматизированного анализа наноразмерных полупроводниковых структур. Комплекс позволяет решать широкий ряд задач, начиная от определения критических размеров объектов и параметров шероховатости их границ, заканчивая специализированными измерениями размерных и морфологических параметров наноструктур сложной формы.

В результате работы решений автоматически создается отчет об измерениях в формате MS Word®, который включает в себя статистические характеристики результатов измерений параметров наноструктуры, представленные в табличном и графическом представлении. Кроме отчета со статистическими данными, пользователь имеет возможность экспортировать все результаты измерений каждого объекта в MS Excel®.

В группу **SIAMS-CP Semi**[™] входят следующие решения:

Анализ регулярных структур контактов/отверстий (круглые/овальные объекты)

Решение предназначено для контроля геометрических параметров регулярных структур круглых контактов/ямок по РЭМ изображениям. В результате работы решения производится автоматический поиск направления ориентировки структуры, реконструкция сетки объектов, что позволяет практически в автоматическом режиме определить большое количество характерных критических размеров таких структур (статистика межрядовых расстояний, шаг структуры в направлении ряда, размеры объектов, смещения и другие).

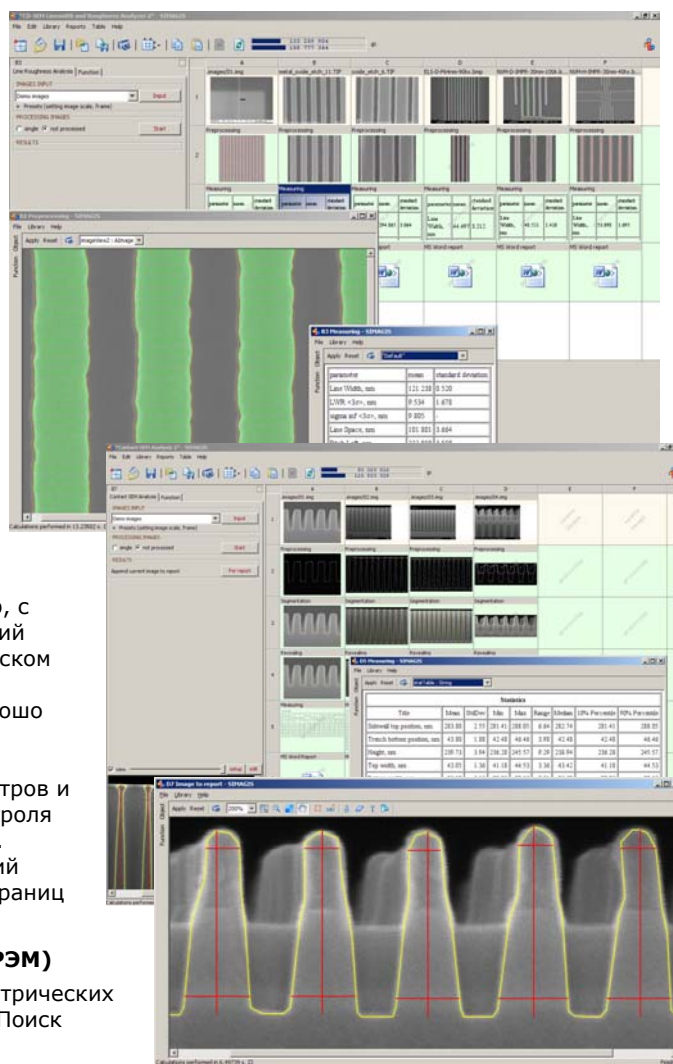
Анализ критических размеров и шероховатости границ линий (РЭМ)

Решение предназначено для измерения критических параметров периодических линейчатых структур, характерных для задач полупроводниковой промышленности, а также калибровочных мер для микроскопов (например, с трапециевидным профилем). Анализ изображений может производиться практически в автоматическом режиме, поскольку в решении реализованы хорошо идентифицируют объекты без дополнительных настроек.

В процессе анализа определяется набор параметров и статистик, принятый для метрологического контроля параметров таких полупроводниковых структур. Измеряемыми параметрами является критический размер линий, шаг, параметры шероховатости границ линий (LER/LWR) и другие характеристики.

Анализ контактных элементов по сколам (РЭМ)

Решение предназначено для определения геометрических параметров канавок/зубцов по сколу образца. Поиск границ и выделение объектов производится в автоматическом режиме с возможностью ручного редактирования. В результате анализа определяются критические параметры объектов (ширина на различных уровнях, углы наклона стенок и другие).



Компания SIAMS обеспечивает полную поддержку клиентов по установке, настройке комплекса решений **SIAMS-CP Nanotech**[™], а также производит обучение работе с решениями.

За более подробной информацией обращайтесь:
Компания **SIAMS**
Тел / Факс: (343) 379-00-34 (35)
E-mail: info@siams.com Web: siams.com